

묵힘과정을 거친 제올라이트 A의 결정화 연구

서 곤

전남대학교 공과대학 공업화학과

(1985년 2월 2일 접수, 1985년 5월 21일 채택)

Investigation on the Crystal Growth of Zeolite A with Aging Step

Gon Seo

Department of Industrial Chemistry, Chonnam University

(Received 2 February 1985; accepted 21 May 1985)

요 약

묵힘과정을 거친 반응물로 부터 제올라이트 A의 결정화 과정을 조사하였다. 결정화 시간에 대한 결정 크기의 선형적 증가로 부터, 묵힘과정에서 핵심생성을 확인할 수 있었다. 본 실험에서 묵힘과정 동안 생성된 핵심의 농도는 10^{10} – 10^{11} cm^{-3} 이었으며, 결정성장 속도 상수는 $0.023 \mu\text{m min}^{-1}$ 이었다. 묵힘과정을 거쳐 핵심이 충분히 생성된 경우, 결정성장 속도는 확산제한, 핵심농도, 반응물의 농도 및 반응물내 제올라이트 A의 전체 표면적으로 나타낼 수 있었다. 고형 반응물이 남아 있는 동안, 제올라이트 A 생성율의 1/3승 값은 결정화 시간에 대해 직선관계를 보여 주었다.

Abstract – The crystal growth of zeolite A from the reactant having aging step was studied. The nuclei formation in aging step was confirmed with the linear increase of crystal size for the crystallization time. The concentration of nuclei formed during aging step in this experiment was 10^{10} – 10^{11} cm^{-3} and rate constant for crystal growth of zeolite A $0.023 \mu\text{m min}^{-1}$. When the sufficient amount of nuclei was formed through the aging step, the crystal growth rate was related with diffusion restriction, concentration of nuclei and the reactant, and the total surface area of zeolite A in the reactant. The cube root of the formation ratio of zeolite A satisfied the linear relationship with crystallization time, when armorphous solid was present.

서 론

제올라이트 A는 결정성 알루미노 실리케이트로 써 촉매, 흡착제, 세제지지제로 쓰이고 있으며 알카리성 알루미네이트와 실리케이트의 혼합액에서 수열(hydrothermal) 합성된다[1]. 이의 결정성장 기구와 속도에 대하여서는 Kerr[2]의 연구를 비롯하여 조성, 결정화온도, seed의 주입, 반응물 상태

등의 영향에 대한 조사[3~6] 등이 보고되어 있다. 제올라이트 A의 결정성장은 용액상태에서 결정화하는 경우 반응물 내에서 핵심(nuclei)이 생성되고, 여기에 용해된 반응물이 축합되어 결정으로 성장하며, 성장된 결정면에서도 성장반응이 계속되는 것으로 받아들여지고 있다. 결정성장 속도에 대하여는 무정형 고형물과 용해된 반응물이 평형상태에 있고, 용해된 반응물이 핵심이나 제올라이트 결정

- John Wiley & Sons, New York (1974).
- 2. Kerr, G.T.: *J. Phys. Chem.*, **70**, 1047 (1966).
 - 3. Angel, C.L. and Flank, W.H.: *ACS Symp. Ser.*, **40**, 194 (1977).
 - 4. Ciric, J.: *J. Colloid and Interface Sci.*, **28**, 315 (1968).
 - 5. Thompson, R.W. and Huber, M.J.: *J. Crystal Growth*, **56**, 711 (1982).
 - 6. Zhdanov, S.P.: *Adv. Chem. Ser.*, **101**, 20 (1971).
 - 7. Liu, S.L.: *Chem. Eng. Sci.*, **24**, 57 (1969).
 - 8. Meise, W. and Schowchow, F.E.: *Adv. Chem. Ser.*, **121**, 169 (1973).
 - 9. Culfaaz, A. and Orbey, P.: *ACS. Symp. Ser.*, **40**, 708 (1977).
 - 10. Freund, F.E.: *J. Crystal Growth*, **34**, 11 (1976).
 - 11. Kacirek, H. and Lechert, H.: *J. Phys. Chem.* **79**, 1589 (1975).
 - 12. 심종섭, 제 9 회 대학생 학술논문대회 (1984. 10. 30).
 - 13. 이한주, 맹원기, 이양환, 1984년 춘계 화학공학회 발표논문초록 p. 31.
 - 14. Breck, D.W.: US Patent No. 3130 007 (1964).
 - 15. Ref. 1 p. 339.
 - 16. Culfaaz, A. and Sand, L.B.: *Adv. Chem. Ser.*, **121**, 140 (1973).